

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 特 許 公 報(B2)

(11) 特許番号

特許第5331862号
(P5331862)

(45) 発行日 平成25年10月30日(2013.10.30)

(24) 登録日 平成25年8月2日(2013.8.2)

(51) Int.Cl.	F I
G09G 3/30 (2006.01)	G09G 3/30 K
G09G 3/20 (2006.01)	G09G 3/20 642F
G09F 9/30 (2006.01)	G09G 3/20 631V
H01L 27/32 (2006.01)	G09G 3/20 624B
G09F 9/00 (2006.01)	G09F 9/30 338

請求項の数 4 (全 22 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号 特願2011-226752 (P2011-226752)
 (22) 出願日 平成23年10月14日(2011.10.14)
 (62) 分割の表示 特願2001-169116 (P2001-169116)
 の分割
 原出願日 平成13年6月5日(2001.6.5)
 (65) 公開番号 特開2012-58739 (P2012-58739A)
 (43) 公開日 平成24年3月22日(2012.3.22)
 審査請求日 平成23年10月17日(2011.10.17)
 (31) 優先権主張番号 特願2000-176168 (P2000-176168)
 (32) 優先日 平成12年6月12日(2000.6.12)
 (33) 優先権主張国 日本国(JP)

(73) 特許権者 000153878
 株式会社半導体エネルギー研究所
 神奈川県厚木市長谷398番地
 (72) 発明者 山崎 舜平
 神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社
 半導体エネルギー研究所内
 (72) 発明者 小山 潤
 神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社
 半導体エネルギー研究所内
 審査官 中村 直行

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 ELディスプレイ

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項1】

同一の絶縁体上に画素部とセンサ部とが設けられ、
 前記画素部は、第1のトランジスタと、前記第1のトランジスタ上のEL素子とを有し、
 前記センサ部は、第2のトランジスタと、前記第2のトランジスタ上のフォトダイオードとを有し、
前記EL素子は、第1の電極と、前記第1の電極上のEL層と、前記EL層上の第2の電極とを有し、
前記フォトダイオードは、第3の電極と、前記第3の電極上の変換層と、前記変換層上の第4の電極とを有し、
前記第1の電極と前記第3の電極とは同一工程により同層に設けられ、
前記EL層は前記第1の電極上に接し、
前記変換層は前記第3の電極上に接し、
 前記センサ部は、環境照度を感知する機能を有し、
前記センサ部により感知された前記環境照度に応じて前記EL素子の発光輝度は調節され、
前記環境照度に対する前記発光輝度の比率は一定であることを特徴とするELディスプレイ。

【請求項2】

同一の絶縁体上に画素部とセンサ部とが設けられ、

前記画素部は、第1のトランジスタと、前記第1のトランジスタ上のE L素子とを有し

、
前記センサ部は、第2のトランジスタと、前記第2のトランジスタ上のフォトダイオードとを有し、

前記E L素子は、第1の電極と、前記第1の電極上のE L層と、前記E L層上の第2の電極とを有し、

前記フォトダイオードは、第3の電極と、前記第3の電極上の変換層と、前記変換層上の第4の電極とを有し、

前記第1のトランジスタと前記第2のトランジスタとは同一工程により設けられ、

前記第1の電極と前記第3の電極とは同一工程により同層に設けられ、

前記E L層は前記第1の電極上に接し、

前記変換層は前記第3の電極上に接し、

前記センサ部は、環境照度を感知する機能を有し、

前記センサ部により感知された前記環境照度に応じて前記E L素子の発光輝度は調節され、

前記環境照度に対する前記発光輝度の比率は一定であることを特徴とするE Lディスプレイ。

【請求項3】

請求項1または請求項2において、

補正回路を有し、

前記補正回路は補正メモリを有し、

前記補正回路は、前記センサ部から出力された信号と前記補正メモリに格納されたデータとに基づいて、補正信号を出力することを特徴とするE Lディスプレイ。

【請求項4】

請求項1乃至請求項3のいずれか一において、

前記第1のトランジスタ及び前記第2のトランジスタ上の第1の絶縁膜を有し、

前記第1の絶縁膜上の珪素を含む第2の絶縁膜を有し、

前記第2の絶縁膜上に前記第1の電極及び前記第3の電極が設けられることを特徴とするE Lディスプレイ。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、電極間に発光性材料を挟んだ素子（以下、発光素子という）を有する装置（以下、発光装置という）を含むモジュール（以下、発光モジュールという）に関する。特に発光性材料としてE L（Electro Luminescence）が得られる化合物を用いた発光素子（以下、E L素子という）を有する発光モジュールに関する。なお、有機E Lディスプレイや有機発光ダイオード（O L E D : Organic Light Emitting Diode）は本発明の発光装置に含まれる。

【0002】

また、本発明に用いることのできる発光性材料は、一重項励起もしくは三重項励起または両者の励起を経由して発光（燐光および/または蛍光）するすべての発光性材料を含む。

【背景技術】

【0003】

近年、E L（Electro Luminescence）が得られる有機化合物（以下、有機E L膜という）を発光層として用いたE L素子の開発が進み、様々な有機E L膜を用いたE L素子が提案されている。そして、そのようなE L素子を発光素子として用いたフラットパネルディスプレイが開発されている。

【0004】

10

20

30

40

50

EL素子を用いた発光装置には、パッシブマトリクス型とアクティブマトリクス型が知られている。パッシブマトリクス型は、ストライプ状の陽極および陰極を互いに直交するように設け、その間にEL膜を挟んだ構造からなるEL素子を用いた発光装置である。また、アクティブマトリクス型は画素ごとに薄膜トランジスタ（以下、TFTと呼ぶ）を設け、EL素子の陽極もしくは陰極の片方に接続したTFTでEL素子に流れる電流を制御する方式である。

【0005】

パッシブ型は構造が簡単で製造コストが低くて済むという利点があるものの、画素部が高精細になる（画素数が多くなる）ほどEL素子の発光強度を高めなくてはならず、その分大きな電流を流さなければならない。しかしながら、大きな電流を流すということは消費電力の増加および寿命の低下が問題となる。

10

【0006】

一方、アクティブマトリクス型は、個々の画素をTFTで制御するためデータを画素に保持しておくことが可能であり、EL素子の発光輝度は画素数によらず一定にしておくことができる。即ち、使用者が見える範囲であれば発光輝度を最小限まで下げて消費電力の増加および寿命の低下を抑えることができる。

【0007】

以上のことから、アクティブマトリクス型の発光装置の方が消費電力は小さいと考えられる。しかしながら、やはり電流駆動であるためまだまだ消費電力が問題となっており、さらに消費電力を下げるのが求められている。

20

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0008】

本発明は、消費電力が低く視認性に優れた発光装置を提供することを課題とする。また、そのような発光装置を用い、消費電力が低く視認性に優れた表示部を有する電気器具を提供することを課題とする。

【課題を解決するための手段】

【0009】

本発明の発光モジュールは、発光モジュールの使用環境の照度（以下、環境照度という）をセンサ部により感知し、それに応じて発光素子の発光輝度を調節し、環境照度に対する発光輝度の比率（環境照度と発光輝度とのコントラスト比）を一定に保つ手段を含む点に特徴がある。

30

【0010】

換言すれば、明るい使用環境ではEL素子の発光輝度を高くして視認性を良好なものにすることができ、暗い使用環境ではEL素子の発光輝度を低くして視認性を損なうことなく消費電力を抑えることができる点に特徴がある。

【0011】

環境照度の感知（モニタリング）は光センサにより行えば良い。本発明では一つもしくは複数の光センサ（典型的にはフォトダイオード）を含むセンサ部を、画像を表示する画素部と同一の絶縁体上に形成する点も特徴としている。即ち、画素部に設けるトランジスタ（薄膜トランジスタおよびバルクシリコンを用いたMOSトランジスタを含む）やEL素子を形成する工程と同一の工程でフォトダイオードを含むセンサ部を形成する点にも特徴がある。

40

【0012】

本発明の発光モジュールは、発光装置に設けられたセンサ部により環境照度が感知され、その出力信号に基づいて補正回路により適正なEL素子の発光輝度およびそれを得るために必要な補正信号が算出される。そして、この補正信号に基づいてEL素子に流れる電流量が補正され、環境照度に対する発光輝度の比率（コントラスト比ともいう）が一定に保たれる。

【0013】

50

本発明の発光モジュールは、明るい環境においては十分に明るい表示となるため視認性に優れ、暗い環境においては良好な視認性を確保しつつ明るさを最小限に抑えることができるため消費電力が低くて済む。従って、本発明の発光モジュールを用いた電気器具は、表示部の視認性に優れ、且つ、消費電力の低いものとなる。

【発明の効果】

【0014】

本発明は、発光装置に設けられたセンサ部により環境照度が感知され、その出力信号に基づいて補正回路により適正なEL素子の発光輝度およびそれを得るために必要な補正信号が算出される。そして、この補正信号に基づいてEL素子に流れる電流量が補正され、環境照度に対する発光輝度の比率が一定に保たれる。

10

【0015】

その結果、明るい環境でも暗い環境でも視認性に優れ、且つ、暗い環境においては消費電力を最小限に抑えることが可能な発光モジュールを得ることができる。従って、本発明の発光モジュールを用いた電気器具は、表示部の視認性に優れ、且つ、消費電力の低いものとすることができる。

【図面の簡単な説明】

【0016】

【図1】発光モジュールの構成を示す図。

【図2】補正回路の構成を示す図。

【図3】補正回路の構成を示す図。

20

【図4】発光モジュールの断面構造を示す図。

【図5】発光モジュールの製造工程を示す図。

【図6】発光モジュールの断面構造を示す図。

【図7】発光モジュールの断面構造を示す図。

【図8】発光モジュールの構成を示す図。

【図9】光センサの構成を示す図。

【図10】光センサの構成を示す図。

【図11】発光モジュールの画素部における構成を示す図。

【図12】発光モジュールの上面構造および断面構造を示す図。

【図13】駆動回路内蔵型発光モジュールの構造を示す図。

30

【図14】コントローラ外付け型発光モジュールの構造を示す図。

【図15】電気器具の具体例を示す図。

【図16】電気器具の具体例を示す図。

【図17】発光モジュールの断面構造を示す図。

【発明を実施するための形態】

【0017】

本発明の実施の形態について説明する。図1(A)は本発明の発光モジュールの回路ブロック図である。発光装置100には画素部101、データ信号(ビデオ信号)側駆動回路102、ゲート信号側駆動回路103、センサ部104が含まれ、発光装置100には補正回路105が接続されている。この補正回路105はセンサ部104から伝送された信号に基づいて画素部101の発光素子の発光輝度を算出するための演算回路を有する。

40

【0018】

補正回路105としてはモノリシックICを用いても良いし、ハイブリッドICもしくはMCM(Multi Chip Module)を用いても良い。モノリシックICを用いる場合、発光装置100に直接実装しても良いし、TAB(Tape Automated Bonding)テープに実装してTCP(Tape Carrier Package)として発光装置100に接続しても良い。また、ハイブリッドICもしくはMCMを用いる場合、発光装置100にTABテープを用いて接続すれば良い。

【0019】

次に、図1(B)はセンサ部104の回路構成の一例を示している。ここではセンサ部

50

104にはフォトダイオード106、リセットTFT107、バッファTFT108および定電流TFT109が含まれる。

【0020】

リセットTFT107はフォトダイオード106に逆バイアス電圧を印加して初期状態に戻す(リセットする)ためのTFTであり、初期状態に戻すタイミングはゲートであるリセット信号線110に伝送される信号で制御する。また、バッファTFT108はフォトダイオード106で感知された信号を増幅するためのTFTであり、定電流TFT109は定電流源として機能するTFTである。

ここではバッファTFT108と定電流TFT109とでソースフォロアとして働くような構成となっており、出力信号は出力線111に伝送される。

10

【0021】

なお、定電圧V1~定電圧V3はフォトダイオード106、リセットTFT107、バッファTFT108もしくは定電流TFT109のソースもしくはドレインに印加された固定電圧である。固定電圧としては、代表的に電源電圧もしくは接地電圧が選択される。

【0022】

なお、図1(B)に示す回路構成は一例であり、光センサとして働く回路構成であれば公知の如何なる構成を用いても良い。また、ここではTFTを能動素子として用いているが、画素部をMOSトランジスタ(半導体基板に形成されたMOS構造のトランジスタ)で形成するような場合は当然MOSトランジスタを用いることになる。

【0023】

次に、図1(C)は画素部101の回路構成の一例を示している。ここでは画素部101にはEL素子112、スイッチングTFT113、電流制御TFT114およびコンデンサ115が含まれる。

20

【0024】

スイッチングTFT113は電流制御TFT114のゲートを制御するためのTFTであり、ゲート線116をゲートとし、データ線(ビデオ線)117に伝送されてきた信号を電流制御TFT114のゲートに伝送する。また、電流制御TFT114はEL素子112に流れる電流を制御するためのTFTであり、電流供給線118に伝送されてきた信号をEL素子112に伝送する。

【0025】

なお、図1(C)に示す回路構成は一例であり、EL素子の発光を制御する回路構成であれば公知の如何なる構成を用いても良い。また、ここではTFTを能動素子として用いているが、画素部をMOSトランジスタで形成するような場合もありうる。

30

【0026】

次に、補正回路105の構成の一例を図2、図3に示す。なお、図2は発光装置100をアナログ信号により駆動する場合(アナログ駆動方式)の例であり、図3は発光装置100をデジタル信号により駆動する場合(デジタル駆動方式)の例である。

【0027】

図2において、補正回路105はA/D変換回路(A/Dコンバータ)201、演算回路202、補正メモリ203およびD/A変換回路(D/Aコンバータ)204を含む。なお、演算回路202と補正メモリ203はMCMとしておくとデータ転送の高速化を図ることができるため好ましい。

40

【0028】

ここで補正メモリ203は、環境照度に対する発光輝度の比率を一定とするようEL素子の発光輝度を補正するための補正データを格納しておくためのメモリである。即ち、環境照度と発光輝度が常に一定のコントラスト比を確保するように、環境照度に応じた発光輝度の適正值データを格納(記憶)しておくためのメモリである。勿論、環境照度に応じた発光輝度の適正值データは、予め取得して格納しておく必要がある。

【0029】

50

ここでまず図2に示したアナログ駆動方式の場合について信号の流れを説明する。なお、アナログ駆動方式の場合、EL素子の電流量を決定する信号は図1(C)のデータ線117に伝送される信号である。

【0030】

センサ部104から伝送された環境照度のデータ(センサ出力信号)はA/D変換回路201でデジタル信号に変換され、演算回路202に入力される。演算回路202では、入力されたセンサ出力信号および補正メモリ203に格納されたデータに基づいて環境照度に対して適正な発光輝度を得るためのデータ信号(ビデオ信号)の適正值が算出される。

【0031】

こうしてセンサ出力信号および補正メモリ203のデータに基づいてシグナルジェネレータ205からのデータ信号(ビデオ信号)が適正值に補正され、その補正されたデータ信号がD/A変換回路204で再びアナログ信号に戻されてデータ信号側駆動回路102に入力される。

【0032】

次に図3に示したデジタル駆動方式の場合について信号の流れを説明する。なお、デジタル駆動方式の場合、EL素子の電流量を決定する信号は図1(C)の電流供給線118に伝送される信号である。

【0033】

センサ部104から環境照度のデータ(センサ出力信号)はA/D変換回路301でデジタル信号に変換され、演算回路302に入力される。演算回路302では、入力されたセンサ出力信号および補正メモリ303に格納されたデータに基づいて環境照度に対して適正な発光輝度を得るために必要な電流量の適正值が算出され、その情報を持った補正信号が出力される。

【0034】

こうしてセンサ出力信号および補正メモリ303のデータに基づいて算出された補正信号がD/A変換回路304でアナログ信号に変換されてEL駆動用電源305に入力される。EL駆動用電源305は画素部101の電流供給線に伝送される信号(以下、電源データ信号という)の電源であり、最終的にEL素子に流れる電流を決定する電源である。EL駆動用電源305には電圧可変器306が接続されており、補正回路105から伝送されてきた補正信号に基づいて電源データ信号が補正されて画素部101に入力される。

【0035】

以上のように、まず発光装置に設けられたセンサ部104により環境照度が感知され、その出力信号(センサ出力信号)に基づいて補正回路105では適正なEL素子の発光輝度を得るために必要なデータ信号もしくは補正信号が算出される。そして、このデータ信号もしくは補正信号に基づいてEL素子に流れる電流量が補正され、適正なコントラスト比の発光輝度が得られる。

【0036】

本発明の実施の形態に示した発光モジュールは、明るい環境においては十分に明るい表示となるため視認性に優れ、暗い環境においては良好な視認性を確保しつつ明るさを最小限に抑えることができるため消費電力が低くて済む。従って、本発明の発光モジュールを用いた電気器具は、表示部の視認性に優れ、且つ、消費電力の低いものとなる。

【実施例1】

【0037】

本実施例では、本発明の発光モジュールに含まれる発光装置の断面構造(但し封止前の状態)について説明する。なお、本実施例では同一の絶縁体上にセンサ部、画素部および画素部を駆動する駆動回路を有した発光装置の例(但し封止前の状態)を示す。なお、センサ部はリセットTFETとそれに接続されたフォトダイオードを示し、駆動回路には基本単位となるCMOS回路を示し、画素部には一つの画素を示す。

【0038】

10

20

30

40

50

図4において、400は絶縁体（絶縁基板、絶縁膜もしくは絶縁膜を表面に有した基板を含む）であり、その上にはセンサ部、駆動回路および画素部が形成されている。センサ部にはリセットTFT451およびフォトダイオード452が設けられている。また、駆動回路にはCMOS回路を構成するnチャンネル型TFT453およびpチャンネル型TFT454が設けられている。また、画素部にはスイッチングTFT455、電流制御TFT456およびEL素子457が設けられている。なお、各TFTは公知の如何なる構造のTFTを用いても良い。本実施例では、各TFTをすべてボトムゲート型TFT（具体的には逆スタガ型TFT）で形成する例を示すが、トップゲート型TFT（典型的にはプレーナ型TFT）を用いることも可能である。

【0039】

また、本実施例ではセンサ部の回路構成は図1（B）に示す構造となっており、画素部の回路構成は図1（C）に示す構造となっている。ただし、このような回路構成に限らず、3個以上のTFTを用いても特に本発明の効果を妨げるものではない。

【0040】

ここで絶縁体400上に形成された各TFTの構造について説明する。nチャンネル型TFT453において、401はゲート電極、402はゲート絶縁膜、403はn型の半導体領域（以下、n型領域という）からなるソース領域、404はn型領域からなるドレイン領域、405aおよび405bはLDD（ライトドープドレイン）領域、406はチャンネル形成領域、407チャンネル保護膜、408は第1層間絶縁膜、409はソース配線、410はドレイン配線である。

【0041】

また、pチャンネル型TFT454において、411はゲート電極、402はゲート絶縁膜、412はp型の半導体領域（以下、p型領域という）からなるソース領域、413はp型領域からなるドレイン領域、414はチャンネル形成領域、415チャンネル保護膜、408は第1層間絶縁膜、416はソース配線、410はドレイン配線である。このドレイン配線はnチャンネル型TFT453と共通の配線となっている。

【0042】

また、リセットTFT451は基本的にはnチャンネル型TFT453と同じ構造（ソース配線もしくはドレイン配線の構成が異なるだけ）であるので詳細な説明は省略する。なお、リセットTFT451はpチャンネル型TFT454と同じ構造とすることも可能である。リセットTFT451の場合、n型領域からなるドレイン領域417とp型領域418との間に非晶質半導体膜（典型的には非晶質珪素膜）419を設け、PIN接合を有するフォトダイオード452が形成されている。なお、420はp型領域418に電圧を印加するための配線である。

【0043】

また、スイッチングTFT455は基本的にはnチャンネル型TFT453と同じ構造であるので詳細な説明は省略する。なお、スイッチングTFT455はpチャンネル型TFT454と同じ構造とすることも可能である。また、ソース領域およびドレイン領域の間に二つ以上のチャンネル形成領域を有した構造（マルチゲート構造）とすることも可能である。

【0044】

また、電流制御TFT456は基本的にはpチャンネル型TFT454と同じ構造（ドレイン配線が画素電極423となるだけ）であるので詳細な説明は省略する。なお、電流制御TFT456はnチャンネル型TFT453と同じ構造とすることも可能である。

【0045】

そして、リセットTFT451、フォトダイオード452、nチャンネル型TFT453、pチャンネル型TFT454、スイッチングTFT455および電流制御TFT456を覆って第2層間絶縁膜（平坦化膜）421が設けられている。

【0046】

また、第2層間絶縁膜421には電流制御TFT456のドレイン領域422に到達す

10

20

30

40

50

るようにコンタクトホールが形成され、ドレイン領域 4 2 2 に接続された画素電極 4 2 3 が設けられている。画素電極 4 2 3 は E L 素子の陽極として機能し、仕事関数の大きい導電膜、代表的には酸化導電膜が用いられる。酸化導電膜としては、酸化インジウム、酸化スズ、酸化亜鉛もしくはそれらの化合物を用いれば良い。また、酸化導電膜に酸化ガリウムを添加しても良い。

【 0 0 4 7 】

次に、4 2 4 は画素電極 4 2 3 の端部を覆うように設けられた絶縁膜であり、本明細書中ではバンクと呼ぶ。バンク 4 2 4 は珪素を含む絶縁膜もしくは樹脂膜で形成すれば良い。樹脂膜を用いる場合、樹脂膜の比抵抗が $1 \times 10^6 \sim 1 \times 10^{12}$ m (好ましくは $1 \times 10^8 \sim 1 \times 10^{10}$ m) となるようにカーボン粒子もしくは金属粒子を添加すると、成膜時の絶縁破壊を抑えることができる。

10

【 0 0 4 8 】

次に、4 2 5 は E L 層である。なお、本明細書中では発光層に対して正孔注入層、正孔輸送層、正孔阻止層、電子輸送層、電子注入層もしくは電子阻止層を組み合わせた積層体を E L 層と定義する。発光層は公知の如何なる材料を用いても良いし、発光層に公知のドーパント(代表的には蛍光色素)を添加しても良い。また、ドーパントとして、三重項励起を經由して発光する有機材料を用いると高い発光効率が得られるので好ましい。

【 0 0 4 9 】

次に、4 2 6 は E L 素子の陰極であり、仕事関数の小さい導電膜が用いられる。仕事関数の小さい導電膜としては、周期表の 1 族もしくは 2 族に属する元素を含む導電膜を用いれば良い。本実施例では、リチウムとアルミニウムとの化合物からなる導電膜を用いる。

20

【 0 0 5 0 】

なお、画素電極(陽極) 4 2 3、E L 層 4 2 5 および陰極 4 2 6 からなる積層体 4 5 7 が E L 素子である。E L 素子 4 5 7 で生成された発光は、絶縁体 4 0 0 側(図中矢印の方向)へと放射される。また、本実施例のように電流制御 T F T に p チャネル型 T F T を用いる場合、電流制御 T F T のドレインには E L 素子の陽極を接続することが好ましい。

【 0 0 5 1 】

なお、陰極 4 2 6 を形成した後、E L 素子 4 5 7 を完全に覆うようにして保護膜(パッシベーション膜) 4 2 7 を設けることは有効である。保護膜 4 2 7 としては、炭素膜、窒化珪素膜もしくは窒化酸化珪素膜を含む絶縁膜からなり、該絶縁膜を単層もしくは組み合わせた積層で用いる。

30

【 0 0 5 2 】

この際、カバレッジの良い膜を保護膜 4 2 7 として用いることが好ましく、炭素膜、特に D L C (ダイヤモンドライクカーボン)膜を用いることは有効である。D L C 膜は室温から 1 0 0 以下の温度範囲で成膜可能であるため、耐熱性の低い E L 層 4 2 5 の上方にも容易に成膜することができる。また、D L C 膜は酸素に対するプロッキング効果が高く、E L 層 4 2 5 の酸化を抑制することが可能である。そのため、この後に続く封止工程を行う間に E L 層 4 2 5 が酸化するといった問題を防止できる。

【 0 0 5 3 】

ここで図 4 に示した構造を得るための製造工程について図 5 に示す。まず、ガラス基板 5 0 1 上にクロム膜からなるゲート電極 5 0 2 ~ 5 0 6 を形成し、その上に窒化酸化珪素膜(S i O x N y で表される絶縁膜)からなるゲート絶縁膜 5 0 7 を形成する。そして、ゲート絶縁膜 5 0 7 の上に非晶質珪素膜を形成し、レーザーアニールにより結晶化した後にパターニングして結晶質珪素膜からなる半導体膜 5 0 8 ~ 5 1 3 を形成する。ここまでの工程は公知の材料および公知の技術を用いれば良い。(図 5 (A))

40

【 0 0 5 4 】

なお、半導体膜 5 0 8 と半導体膜 5 0 9 との間の距離は 1 μ m 以下、好ましくは 0 . 3 ~ 0 . 5 μ m としておく。

【 0 0 5 5 】

50

次に、半導体膜508～513上に酸化珪素膜からなる絶縁膜514～519が形成され、その上からリンもしくは砒素を添加する。このとき添加方法は公知の技術を用いれば良い。こうしてn型領域520～525が形成される。n型領域520～525にはリンもしくは砒素が $1 \times 10^{20} \sim 1 \times 10^{21}$ atoms/cm³の濃度で含まれる。(図5(B))

【0056】

次に、絶縁膜514～519をゲート電極502～506をマスクとして裏面露光によりパターンニングし、絶縁膜(チャネル保護膜)526～530を形成する。そして、その状態で再びリンもしくは砒素を公知の技術を用いて添加する。

こうしてn型領域531～541が形成される。n型領域531～541にはリンもしくは砒素が $1 \times 10^{17} \sim 1 \times 10^{19}$ atoms/cm³の濃度で含まれる。(図5(C))

10

【0057】

次に、レジスト542～544を設け、ボロンを公知の技術により添加する。こうしてp型領域545～549が形成される。p型領域545～549にはボロンが $3 \times 10^{20} \sim 5 \times 10^{21}$ atoms/cm³の濃度で含まれる。なお、p型領域545～549には既にリンもしくは砒素が添加されているが、ボロンが3倍以上の濃度で添加されるため、完全にn型からp型に反転する。(図5(D))

【0058】

次に、レジスト542～544を除去し、酸化珪素膜と窒化酸化珪素膜との積層構造からなる第1層間絶縁膜550を形成する。そして、第1層間絶縁膜550にコンタクトホールを形成し、モリブデンとタングステンとの積層構造からなる配線551～558を形成する。その後、半導体膜からなる変換層559を形成する。変換層559はフォトダイオードにおいて光吸収を行い、キャリアを発生させるための層であり、太陽電池のi層(光電変換層)に相当する。(図5(E))

20

【0059】

なお、変換層559としてはPIN接合を有する公知の層構造を用いることができる。また、光の入射側から見て、PIN接合となっても良いし、NIP接合となっても良い。また、変換層559の材料としては非晶質半導体膜、結晶質半導体膜もしくは微結晶半導体膜のいずれの膜を用いても良い。

【0060】

この後は、図4に示すように、第2層間絶縁膜421、画素電極423、バンク424、EL層425、陰極426および保護膜427を形成すれば、図4に示す断面構造の発光装置が完成する。

30

【0061】

本実施例の断面構造を含む発光装置を用いることで、明るい環境においては視認性に優れ、暗い環境においては良好な視認性を確保しつつ消費電力の低い発光モジュールが得られる。なお、本実施例は図1および図2または図1および図3に示す構成と組み合わせて実施すれば良い。

【実施例2】

【0062】

本実施例では、実施例1とは異なる構造の発光装置(但し封止前の状態)の例を示す。なお、本実施例では実施例1と異なる部分について説明を行う。図4と同一の符号が付してある部分は実施例1の説明を参照すれば良い。

40

【0063】

図6において、絶縁体400上にはセンサ部、駆動回路および画素部が設けられている。センサ部にはリセットTF T 451およびフォトダイオード(フォトセンサ)601が含まれ、駆動回路にはnチャネル型TF T 453およびpチャネル型TF T 454からなるCMOS回路が含まれ、画素部にはスイッチングTF T 455、電流制御TF T 456およびEL素子457が含まれている。

【0064】

本実施例では、フォトダイオード601の構造が実施例1と異なり、リセットTF T 4

50

51のソースもしくはドレインとなる配線603、変換層604および反射側電極（光が反射する側の電極）605からフォトダイオードが形成される。また、本実施例では第2層間絶縁膜421の上に珪素を含む絶縁膜からなるバッファ層606を設けている。バッファ層606は第2層間絶縁膜421と配線603との密着性を高めるとともに、変換層604を形成する際に第2層間絶縁膜421がエッチングされるのを防ぐ効果も持つ。

【0065】

なお、配線603は画素電極423と同一工程で形成されるため、可視光に対して透明である。また、反射側電極となる導電膜は、反射率の高い導電膜が好ましく、アルミニウムや銀を主成分とする導電膜を用いれば良い。その際、変換層604と反射側電極605との間に酸化物導電膜をバッファ層として設けることで、変換層604と反射側電極605の間の反応を防止することができる。

10

【0066】

本実施例の断面構造を含む発光装置を用いることで、明るい環境においては視認性に優れ、暗い環境においては良好な視認性を確保しつつ消費電力の低い発光モジュールが得られる。なお、本実施例は図1および図2または図1および図3に示す構成と組み合わせて実施すれば良い。

【実施例3】

【0067】

本実施例では、実施例1とは異なる構造の発光装置（但し封止前の状態）の例を示す。なお、本実施例では実施例1と異なる部分について説明を行う。図4と同一の符号が付してある部分は実施例1の説明を参照すれば良い。

20

【0068】

図7において、絶縁体400上にはセンサ部、駆動回路および画素部が設けられている。センサ部にはリセットTFT701およびフォトダイオード（フォトセンサ）702が含まれ、駆動回路にはnチャンネル型TFT703およびpチャンネル型TFT704からなるCMOS回路が含まれ、画素部にはスイッチングTFT705、電流制御TFT706およびEL素子707が含まれている。

【0069】

まず、本実施例では各TFTのソース配線もしくはドレイン配線がチャンネル形成領域を覆うように設けられている点に特徴がある。本実施例の構造では、外部からの光がTFTのチャンネル形成領域に直接当たる方向から到達するため、その光を遮ることでリーク電流の増加を防ぐために図7のような形状としている。

30

【0070】

また、本実施例では電流制御TFT706としてnチャンネル型TFTを用いている。なお、電流制御TFT706は基本的には図4に示したnチャンネル型TFT453と同じ構造（ソース電極の形状が異なるだけ）であるので詳細な説明は省略する。なお、電流制御TFT706はpチャンネル型TFT454と同じ構造とすることも可能である。

【0071】

また、本実施例では、フォトダイオード702の構造が実施例1と異なり、リセットTFT701のソースもしくはドレインとなる配線711、変換層712および透過側電極（光が透過する側の電極）713でフォトダイオードが形成され、透過側電極713には引出配線714が接続される。変換層712は実施例2の変換層604と同様の構成とすることができる。また、透過側電極713は酸化物導電膜を用いて形成すれば良い。

40

【0072】

画素部においては、この引出配線714と同一工程で画素電極715が形成される。画素電極715はEL素子707の陰極として機能する電極であり、周期表の1族もしくは2族に属する元素を含む導電膜を用いて形成されている。本実施例では、リチウムとアルミニウムとの化合物からなる導電膜を用いる。なお、本実施例のように電流制御TFTに陰極が接続される場合は電流制御TFTとしてnチャンネル型TFTを用いることが好ましい。

50

【 0 0 7 3 】

画素電極 7 1 5 が形成されたら絶縁膜（バンク）4 2 4 を形成し、E L 層 7 1 6、酸化物導電膜からなる陽極 7 1 7 および保護膜 7 1 8 を形成し、図 7 の構造の発光装置（但し封止前の状態）が完成する。E L 層 7 1 6、陽極 7 1 7 および保護膜 7 1 8 の材料や構成に関しては実施例 1 を参考にすれば良い。

【 0 0 7 4 】

本実施例の断面構造を含む発光装置を用いることで、明るい環境においては視認性に優れ、暗い環境においては良好な視認性を確保しつつ消費電力の低い発光モジュールが得られる。なお、本実施例は図 1 および図 2 または図 1 および図 3 に示す構成と組み合わせて実施すれば良い。

【 実施例 4 】

【 0 0 7 5 】

本実施例では、実施例 1 とは異なる構造の発光装置（但し封止前の状態）の例を示す。なお、本実施例では実施例 1 と異なる部分について説明を行う。図 4 と同一の符号が付してある部分は実施例 1 の説明を参照すれば良い。

【 0 0 7 6 】

図 1 7 において、絶縁体 4 0 0 上にはセンサ部および画素部が設けられている。なお、実施例 2 または実施例 3 と同様に同一絶縁体上に駆動回路を設けることも可能である。

【 0 0 7 7 】

センサ部にはリセット T F T 1 7 0 1 およびフォトダイオード（フォトセンサ）1 7 0 2 が含まれ、画素部にはスイッチング T F T 1 7 0 3、電流制御 T F T 1 7 0 4 および E L 素子 1 7 0 5 が含まれている。

【 0 0 7 8 】

本実施例では電流制御 T F T 1 7 0 4 として p チャネル型 T F T を用いている。なお、電流制御 T F T 1 7 0 4 は基本的には図 4 に示した電流制御 T F T 4 5 6 と同じ構造であるので詳細な説明は省略する。なお、電流制御 T F T 1 7 0 4 は図 4 の n チャネル型 T F T 4 5 5 と同じ構造とすることも可能である。

【 0 0 7 9 】

また、本実施例では、フォトダイオード 1 7 0 2 の構造が実施例 1 と異なっている。即ち、リセット T F T 1 7 0 1 のソースもしくはドレインとなる酸化物導電膜からなる配線 1 7 1 1、n 型半導体層 1 7 1 2、変換層（i 型半導体層）1 7 1 3、p 型半導体層 1 7 1 4 および受光側電極（光を受光する側の電極）1 7 1 5 でフォトダイオード 1 7 0 2 が形成される。

【 0 0 8 0 】

このとき、配線 1 7 1 1 は、画素電極（E L 素子 1 7 0 5 の陽極）1 7 1 6 と同一工程で形成される。また、受光側電極 1 7 1 5 は酸化物導電膜を用いて形成すれば良い。なお、画素部において配線 1 7 1 1 と同一工程で形成される画素電極 1 7 1 6 は、電流制御 T F T 1 7 0 4 のドレインに電氣的に接続される。

【 0 0 8 1 】

画素電極 1 7 1 6 が形成されたら絶縁膜（バンク）4 2 4 を形成し、E L 層 4 2 5、陰極 4 2 6 および保護膜 4 2 7 を形成し、図 1 7 の構造の発光装置（但し封止前の状態）が完成する。E L 層 4 2 5、陰極 4 2 6 および保護膜 4 2 7 の材料や構成に関しては実施例 1 を参考にすれば良い。

【 0 0 8 2 】

本実施例の断面構造を含む発光装置を用いることで、明るい環境においては視認性に優れ、暗い環境においては良好な視認性を確保しつつ消費電力の低い発光モジュールが得られる。なお、本実施例は図 1 および図 2 または図 1 および図 3 に示す構成と組み合わせて実施すれば良い。

【 実施例 5 】

【 0 0 8 3 】

10

20

30

40

50

本実施例では、同一の絶縁体上にセンサ部、補正回路、駆動回路および画素部を設けた発光装置について説明を行う。

【0084】

図8において800で示されるのは本実施例の発光装置であり、801は画素部、802はデータ信号側駆動回路、803はゲート信号側駆動回路、804はセンサ部、805は補正回路である。なお、画素部801の構成は図1(C)を参照すれば良く、センサ部804の構成は図1(B)を参照すれば良い。

【0085】

本実施例では、図2もしくは図3に示した構成の補正回路805をセンサ部、駆動回路および画素部と同一の絶縁体上に形成した点に特徴がある。即ち、本実施例の発光装置800は、センサ部804にて感知された環境照度に基づいて補正回路805から補正されたデータ信号が出力され、画素部801の発光輝度を適正な強度に調節する機能が備わっている。

【0086】

勿論、本実施例の構成では、補正回路805をすべてトランジスタ(TFTもしくはMOSトランジスタ)を用いて形成することになる。その際、図4のnチャネル型TFT453およびpチャネル型TFT454からなるCMOS回路を基本単位として回路設計を行えば良い。

【0087】

なお、本実施例の構成は実施例1～実施例4のいずれの構成とも組み合わせて実施することが可能である。本実施例の発光装置を含む発光モジュールは補正回路が内蔵されることで図1の構造に比べて軽量化を図ることができ、補正回路と駆動回路との接続に要するピン数を減らすことが可能である。

【実施例6】

【0088】

本発明の発光モジュールに含まれるセンサ部には、光センサ(フォトセンサ)として機能する回路を用いることができる。本実施例ではアクティブ型の光センサの回路構成の例として図9(A)、(B)の構成を示す。

【0089】

図9(A)に示す光センサには、フォトダイオード901、第1リセットTFT902、バッファTFT903、負荷容量904および第2リセットTFT905が含まれる。また、第1リセットTFT902のゲートには第1リセット信号線906が接続され、第2リセットTFT905のゲートには第2リセット信号線907が接続される。また、908は出力線である。

【0090】

また、図9(B)に示すセンサ部には、フォトダイオード911、リセットTFT912、バッファTFT913および負荷抵抗(負荷容量でも良い)914が含まれる。また、リセットTFT912のゲートにはリセット信号線915が接続される。また、916は出力線である。

【0091】

なお、図9(A)、(B)において、定電圧V1、定電圧V2はフォトダイオード、リセットTFT、バッファTFTのソースもしくはドレインに印加された固定電圧である。定電圧としては、代表的に電源電圧もしくは接地電圧が選択される。

【0092】

本発明の発光モジュールのセンサ部には、図9(A)もしくは図9(B)に示す回路構成の光センサを一つもしくは複数設けることが可能である。また、図9(A)、(B)に示す回路構成は一例であり、ここではTFTを能動素子として用いているが、画素部をMOSトランジスタで形成するような場合は当然MOSトランジスタを用いることになる。また、TFTを用いる場合、トップゲート型TFTを用いてもボトムゲート型TFTを用いても構わない。

10

20

30

40

50

【 0 0 9 3 】

なお、本実施例の構成は実施例 1 ~ 実施例 5 のいずれの構成とも組み合わせて実施することが可能である。

【 実施例 7 】

【 0 0 9 4 】

本発明の発光モジュールに含まれるセンサ部としては、光センサとして機能する回路を用いることができる。本実施例ではパッシブ型の光センサの回路構成の例として図 1 0 の構成を示す。

【 0 0 9 5 】

図 1 0 に示す光センサには、フォトダイオード 1 0 0 1 およびリセット T F T 1 0 0 2 10
含まれる。また、リセット T F T 1 0 0 2 のゲートにはリセット信号線 1 0 0 3 が接続される。また、1 0 0 4 は出力線である。

【 0 0 9 6 】

なお、図 1 0 において、定電圧 V 1 はフォトダイオード印加された固定電圧である。定電圧としては、代表的に電源電圧もしくは接地電圧が選択される。

【 0 0 9 7 】

本発明の発光モジュールのセンサ部には、図 1 0 に示す回路構成の光センサを一つもしくは複数設けることが可能である。また、図 1 0 に示す回路構成は一例であり、ここでは T F T を能動素子として用いているが、画素部を M O S トランジスタで形成するような場合は当然 M O S トランジスタを用いることになる。また、T F T を用いる場合、トップゲート型 T F T を用いてもボトムゲート型 T F T を用いても構わない。 20

【 0 0 9 8 】

なお、本実施例の構成は実施例 1 ~ 実施例 5 のいずれの構成とも組み合わせて実施することが可能である。

【 実施例 8 】

【 0 0 9 9 】

本実施例では、画素部における画素の構造を図 1 (B) とは異なる構造とした場合について説明する。なお、図 1 (B) と同じ符号を付してある部分については図 1 (B) の説明を参照すれば良い。

【 0 1 0 0 】

図 1 1 (A) の構成では、スイッチング T F T 1 1 3 と電流制御 T F T 1 1 4 のゲートとの間に消去 T F T 1 1 0 1 が接続されている点に特徴がある。消去 T F T 1 1 0 1 は電流制御 T F T 1 1 4 に印加されたゲート電圧を強制的に 0 V に変圧するための T F T である。消去 T F T 1 1 0 1 のソースもしくはドレインの一方は電流制御 T F T 1 1 4 のゲート電極に、他方は電流供給線 1 1 8 に接続され、ゲート電極は消去 T F T のゲート電極となる配線 (消去ゲート線) 1 1 0 2 に接続される。 30

【 0 1 0 1 】

また、図 1 1 (B) の構成は、公知の構造であり、画素内に第 1 T F T 1 1 0 3、第 2 T F T 1 1 0 4、第 3 T F T 1 1 0 5、第 4 T F T 1 1 0 6、第 1 コンデンサ 1 1 0 7 および第 2 コンデンサ 1 1 0 8 が設けられている。また、データ線 1 1 0 9、第 1 ゲート線 1 1 1 0、第 2 ゲート線 1 1 1 1、第 3 ゲート線 1 1 1 2 および電流供給線 1 1 1 3 が図のように設けられ、各 T F T に信号を伝送する構成となっている。また、第 4 T F T 1 1 0 6 には E L 素子 1 1 1 4 が接続されている。 40

【 0 1 0 2 】

本実施例の発光モジュールの画素部は、図 1 1 (A) または (B) に示す構造の画素が複数設けられている。また、図 1 1 に示す回路構成は一例であり、ここでは T F T を能動素子として用いているが、M O S トランジスタで形成することも可能である。また、トップゲート型 T F T を用いてもボトムゲート型 T F T を用いても構わない。

【 0 1 0 3 】

なお、本実施例の構成は実施例 1 ~ 実施例 7 のいずれの構成とも組み合わせて実施する 50

ことが可能である。

【実施例 9】

【0104】

本発明の発光モジュールは、データ信号側駆動回路を公知の分割駆動法により駆動することで動作周波数を下げることが可能である。分割駆動法とは、点順次方式の駆動方法を行う際に、複数の画素に同時にデータ信号を書き込むことで動作周波数を下げる駆動方法である。

【0105】

この場合、 n 分割で分割駆動するにはデータ信号（ビデオ信号）が n 本必要となる。そして、シフトレジスタの出力タイミングに同期して、 n 個の画素を1ブロックとしてブロック単位にデータ信号が書き込まれていく。こうすることでデータ信号側駆動回路の動作周波数を $1/n$ に下げることができる。

【0106】

また、 n 本のデータ信号を設け、シフトレジスタの出力タイミングに同期して、 n 個おきに画素にデータ信号を書き込むこともできる。この場合もデータ信号側駆動回路の動作周波数を $1/n$ に下げることができる。

【0107】

なお、本実施例の構成は実施例1～実施例8のいずれの構成とも組み合わせて実施することが可能である。

【実施例 10】

【0108】

本実施例では、EL素子を保護するための封止（または封入）工程まで行った後の本発明の発光モジュールについて図12（A）、（B）を用いて説明する。

なお、本実施例の封止構造は実施例1～実施例4に示したいずれの構造に対しても実施することが可能である。また、必要に応じて図4の符号を引用する。

【0109】

図12（A）は、EL素子の封止までを行った状態を示す上面図、図12（B）は図12（A）をA-A'で切断した断面図である。点線で示された1200は画素部、1201はソース信号側駆動回路、1202はゲート信号側駆動回路、1203はセンサ部である。また、1204はカバー材、1205は第1シール材、1206は第2シール材である。

【0110】

また、1207は外部入力端子となるTABテープであり、外部駆動回路や補正回路からビデオ信号やクロック信号を受け取る。なお、ここではTABテープしか図示されていないが、このTABテープにはプリント配線板（PWB）が取り付けられていても良いし、TCPとなっても良い。

【0111】

次に、断面構造について図12（B）を用いて説明する。絶縁体400の上方には画素部1200、ソース信号側駆動回路1201およびセンサ部1203が形成されており、画素部1200は電流制御TF T 456とそのドレインに電氣的に接続された画素電極423を含む複数の画素を含む。また、ソース信号側駆動回路1201は n チャンネル型TF T 453と p チャンネル型TF T 454とを組み合わせたCMOS回路を含む。また、センサ部1203はリセットTF T 451に接続されたフォトダイオード452を含む。なお、絶縁体400には偏光板（代表的には円偏光板）を貼り付けても良い。

【0112】

画素電極423はEL素子の陽極として機能する。また、画素電極423の両端にはバンク424が形成され、画素電極423上にはEL層425およびEL素子の陰極426が形成される。陰極426は全画素に共通の配線としても機能し、最終的にTABテープ1207に電氣的に接続されている。さらに、画素部1200、ソース信号側駆動回路1201およびセンサ部1203に含まれる素子は全て保護膜427で覆われている。

10

20

30

40

50

【0113】

また、第1シール材1205によりカバー材1204が貼り合わされている。
 なお、カバー材1204とEL素子との間隔を確保するためにスペーサを設けても良い。
 そして、第1シール材1205の内側には空隙1208が形成されている。なお、第1シール材1205は水分や酸素を透過しない材料であることが望ましい。さらに、空隙1208の内部に吸湿効果をもつ物質や酸化防止効果をもつ物質を設けることは有効である。

【0114】

なお、カバー材1204の表面および裏面には保護膜として炭素膜（具体的にはダイヤモンドライクカーボン膜）1209a、1209bを2～30nmの厚さに設けると良い。
 このような炭素膜は、酸素および水の侵入を防ぐとともにカバー材1204の表面を機械的に保護する役割をもつ。

10

【0115】

また、カバー材1204を接着した後、第1シール材1205の露呈面を覆うように第2シール材1206を設けている。第2シール材1206は第1シール材1205と同じ材料を用いることができる。

【0116】

以上のような構造でEL素子を封入することにより、EL素子を外部から完全に遮断することができ、外部から水分や酸素等のEL層の酸化による劣化を促す物質が侵入することを防ぐことができる。従って、信頼性の高い発光装置が得られる。

【0117】

なお、図12(A)、(B)に示したように、同一の絶縁体上に画素部、駆動回路およびセンサ部を有し、TABテープまで取り付けられた発光モジュールを本明細書中では駆動回路内蔵型発光モジュールと呼ぶ。

20

【実施例11】

【0118】

実施例10において、図12に示した駆動回路内蔵型発光モジュールは、同一の絶縁体上に画素部および駆動回路が一体形成された例であるが、駆動回路を外付けIC（集積回路）で設けることも可能である。このような場合、構造は図13(A)のようになる。

【0119】

図13(A)に示すモジュールは、TFEおよびEL素子を含む画素部が形成された基板（アクティブマトリクス基板）10（画素部11、配線12a、12bおよびセンサ部13を含む）にTABテープ14が取り付けられ、そのTABテープ14を介してプリント配線板15が取り付けられている。ここでプリント配線板15の回路ブロック図を図13(B)に示す。

30

【0120】

図13(B)に示すように、プリント配線板15の内部には少なくともI/Oポート（入出力部ともいう）16、19、ソース信号側駆動回路17、ゲート信号側駆動回路18および補正回路20として機能するICが設けられている。

【0121】

このように、同一の絶縁体上に画素部およびセンサ部が形成された基板にTABテープが取り付けられ、そのTABテープを介して駆動回路としての機能を有するプリント配線板が取り付けられた構成のモジュールを、本明細書では特に駆動回路外付け型発光モジュールと呼ぶことにする。

40

【0122】

また、図14(A)に示すモジュールは、駆動回路内蔵型発光モジュール30（画素部31、ソース信号側駆動回路32、ゲート信号側駆動回路33、配線32a、33a、センサ部34およびTABテープ35を含む）に、TABテープ35を介してプリント配線板36が取り付けられている。ここでプリント配線板36の回路ブロック図を図14(B)に示す。

【0123】

50

図14(B)に示すように、プリント配線板36の内部には少なくともI/Oポート37、40、コントロール部38およびメモリ部39として機能するICが設けられている。なお、メモリ部39は図2もしくは図3の補正メモリとしても機能し、コントロール部38に含まれる補正回路により発光輝度の調整が行われる。また、コントロール部38は、駆動回路に伝送される信号もしくはタイミング信号といった各種信号の制御も行うことが可能である。

【0124】

このように、同一の絶縁体上に画素部、駆動回路およびセンサ部が形成された駆動回路内蔵型発光モジュールにコントローラとしての機能を有するプリント配線板が取り付けられた構成のモジュールを、本明細書では特にコントローラ外付け型発光モジュールと呼ぶことにする。

【実施例12】

【0125】

本発明を実施して形成された発光モジュールは様々な電気器具に用いられ、画素部は映像表示部として用いられる。本発明の電気器具としては、ビデオカメラ、デジタルカメラ、ゴーグル型ディスプレイ(ヘッドマウントディスプレイ)、ナビゲーションシステム、音響機器、ノート型パーソナルコンピュータ、ゲーム機器、携帯機器(モバイルコンピュータ、携帯電話、携帯型ゲーム機または電子書籍)、記録媒体を備えた画像再生装置などが挙げられる。それら電気器具の具体例を図15、図16に示す。

【0126】

図15(A)はELディスプレイであり、筐体2001、支持台2002、表示部2003を含む。本発明の発光モジュールは表示部2003に用いることができる。本発明の発光モジュールを表示部に用いることでELディスプレイの視認性を向上させ、消費電力を下げる事が可能である。

【0127】

図15(B)はビデオカメラであり、本体2101、表示部2102、音声入力部2103、操作スイッチ2104、バッテリー2105、受像部2106を含む。本発明の発光モジュールは表示部2102に用いることができる。

【0128】

図15(C)はデジタルカメラであり、本体2201、表示部2202、接眼部2203、操作スイッチ2204を含む。本発明の発光モジュールは表示部2202に用いることができる。

【0129】

図15(D)は記録媒体を備えた画像再生装置(具体的にはDVD再生装置)であり、本体2301、記録媒体(CD、LDまたはDVD等)2302、操作スイッチ2303、表示部(a)2304、表示部(b)2305を含む。表示部(a)は主として画像情報を表示し、表示部(b)は主として文字情報を表示するが、本発明の発光モジュールはこれら表示部(a)、(b)に用いることができる。なお、記録媒体を備えた画像再生装置には、CD再生装置、ゲーム機器なども含まれる。

【0130】

図15(E)は携帯型(モバイル)コンピュータであり、本体2401、表示部2402、受像部2403、操作スイッチ2404、メモリスロット2405を含む。本発明の発光モジュールは表示部2402に用いることができる。この携帯型コンピュータはフラッシュメモリや不揮発性メモリを集積化した記録媒体に情報を記録したり、それを再生したりすることができる。

【0131】

図15(F)はパーソナルコンピュータであり、本体2501、筐体2502、表示部2503、キーボード2504を含む。本発明の発光モジュールは表示部2503に用いることができる。

【0132】

10

20

30

40

50

また、上記電気器具はインターネットやCATV（ケーブルテレビ）などの電子通信回線を通じて配信された情報を表示することが多くなり、特に動画情報を表示する機会が増してきている。表示部にEL素子を有した発光モジュールを用いた場合、EL素子の応答速度が非常に高いため遅れのない動画表示が可能となる。

【0133】

また、発光モジュールは発光している部分が電力を消費するため、発光部分が極力少なくなるように情報を表示することが望ましい。従って、携帯情報端末、特に携帯電話や音響機器のような文字情報を主とする表示部に発光モジュールを用いる場合には、非発光部分を背景として文字情報を発光部分で形成するように駆動することが望ましい。

【0134】

ここで図16(A)は携帯電話であり、キー操作を行う部位（操作部）2601、情報表示を行う部位（情報表示部）2602であり、操作部2601および情報表示部2602は連結部2603で連結している。また、操作部2601には音声入力部2604、操作キー2605が設けられ、情報表示部2602には音声出力部2606、表示部2607が設けられている。

【0135】

本発明の発光モジュールは表示部2607に用いることができる。なお、表示部2607に発光モジュールを用いる場合、黒色の背景に白色の文字を表示することで携帯電話の消費電力を抑えることができる。

【0136】

図16(A)に示した携帯電話の場合、表示部2604に用いた発光モジュールにCMOS回路でセンサ（CMOSセンサ）を内蔵させ、指紋もしくは手相を読みとることで使用者を認証する認証システム用端末として用いることもできる。また、外部の明るさ（照度）を読みとり、設定されたコントラストで情報表示が可能となるように発光させることもできる。

【0137】

さらに、操作スイッチ2605を使用している時に輝度を下げ、操作スイッチの使用が終わったら輝度を上げることで低消費電力化することができる。また、着信した時に表示部2604の輝度を上げ、通話中は輝度を下げることによっても低消費電力化することができる。また、継続的に使用している場合に、リセットしない限り時間制御で表示がオフになるような機能を持たせることで低消費電力化を図ることもできる。なお、これらはマニュアル制御であっても良い。

【0138】

また、図16(B)は車載用オーディオであり、筐体2701、表示部2702、操作スイッチ2703、2704を含む。本発明の発光モジュールは表示部2702に用いることができる。また、本実施例では音響機器の例として車載用オーディオ（カーオーディオ）を示すが、据え置き型のオーディオ（オーディオコンポーネント）に用いても良い。なお、表示部2704に発光モジュールを用いる場合、黒色の背景に白色の文字を表示することで消費電力を抑えられる。

【0139】

以上の様に、本発明の適用範囲は極めて広く、あらゆる分野の電気器具に用いることが可能である。その結果、明るい環境でも暗い環境でも視認性に優れ、且つ、暗い環境においては消費電力を最小限に抑えることが可能な発光モジュールを用いることで、電気器具の表示部の視認性を向上させ、且つ、消費電力を下げる事が可能となる。また、本実施例の電気器具は実施例1～11のいずれの構成を含む発光モジュールを用いても良い。

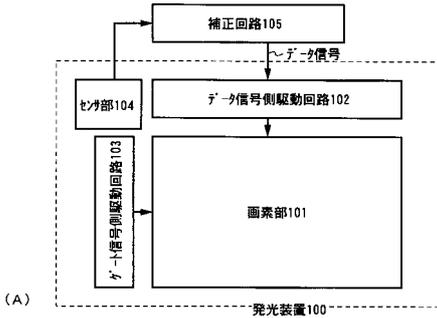
10

20

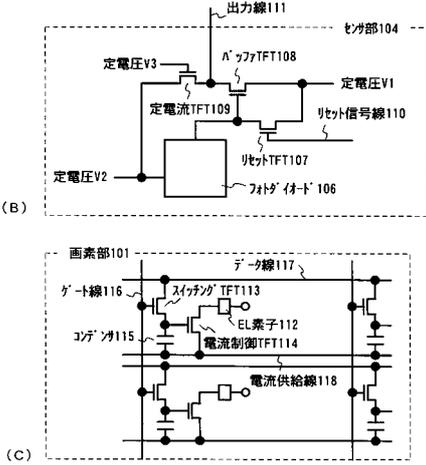
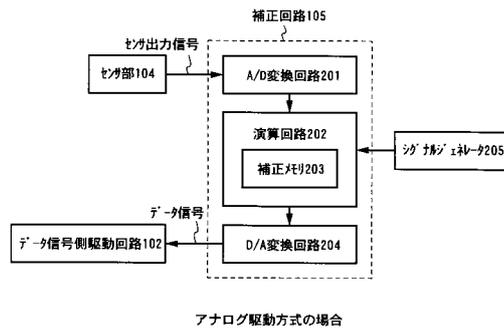
30

40

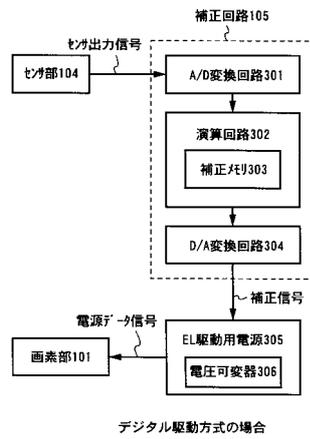
【図1】



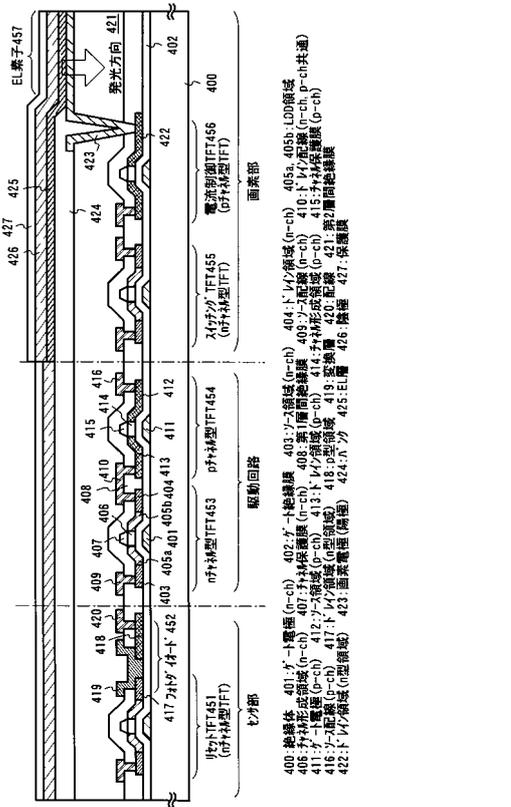
【図2】



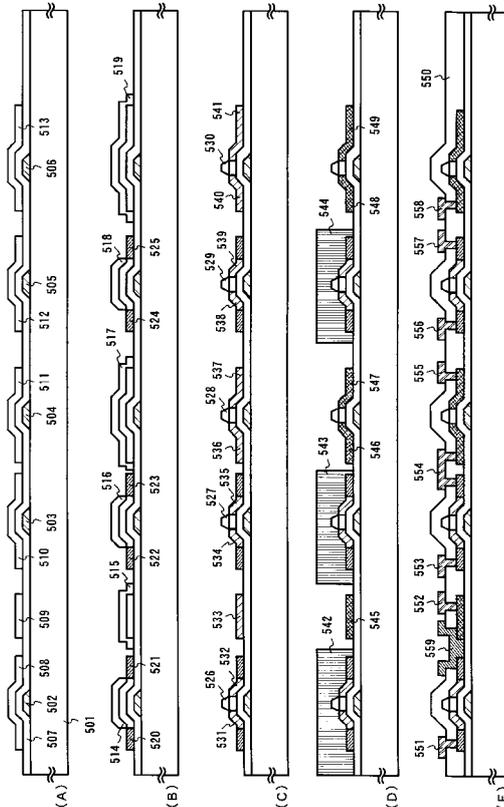
【図3】



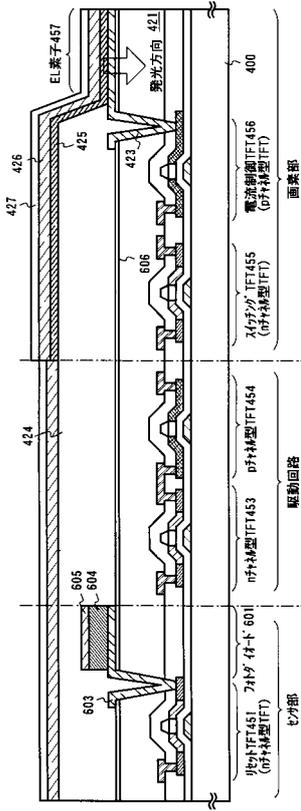
【図4】



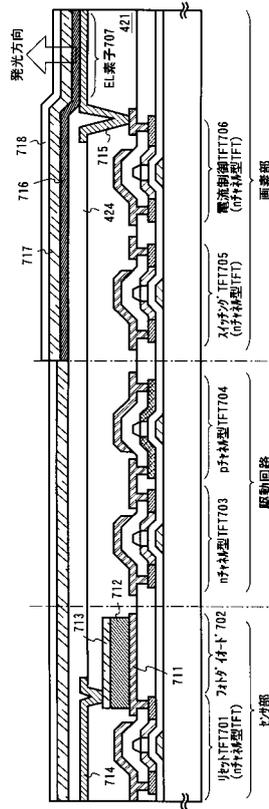
【図5】



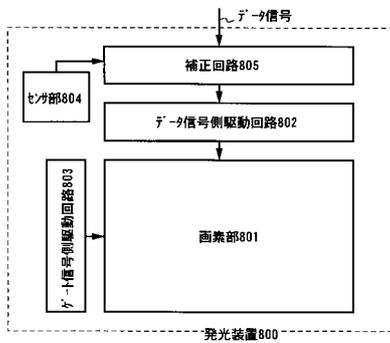
【図6】



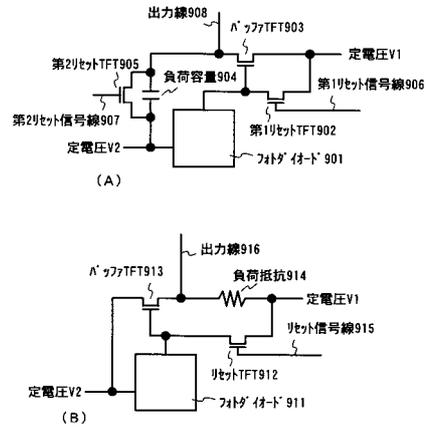
【図7】



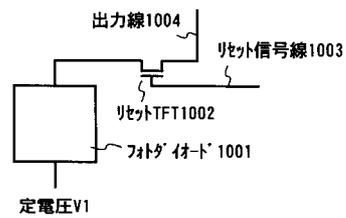
【図8】



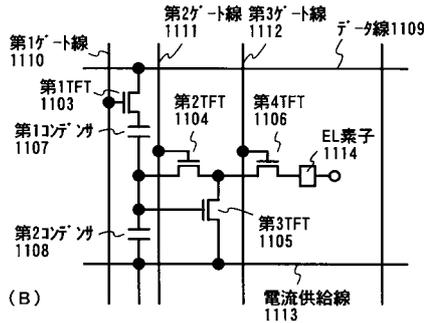
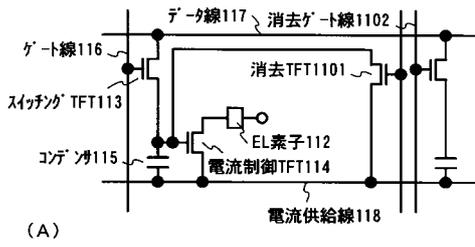
【図9】



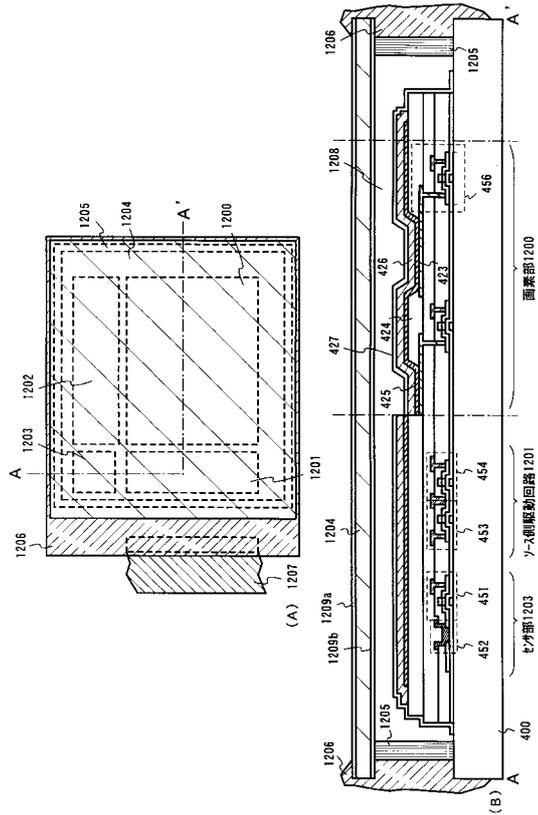
【図10】



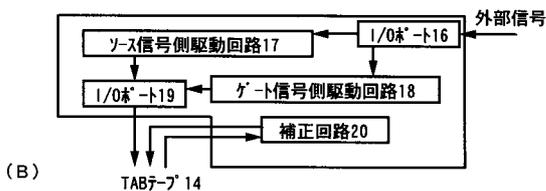
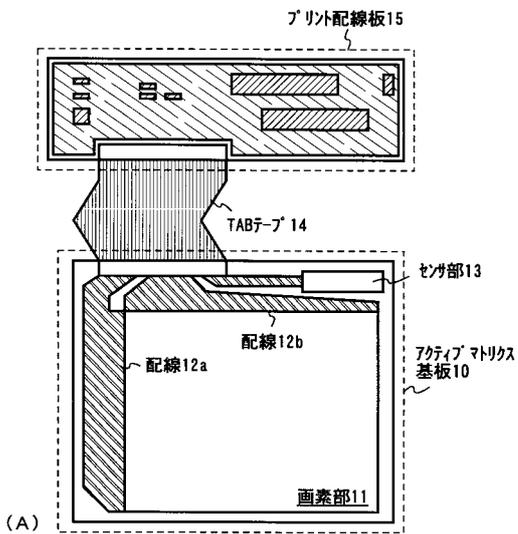
【図11】



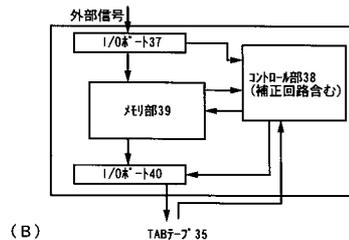
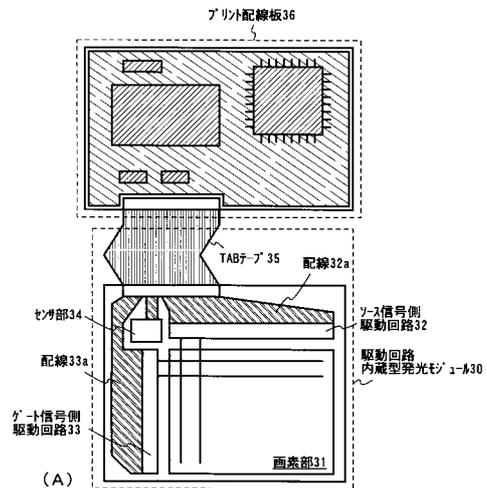
【図12】



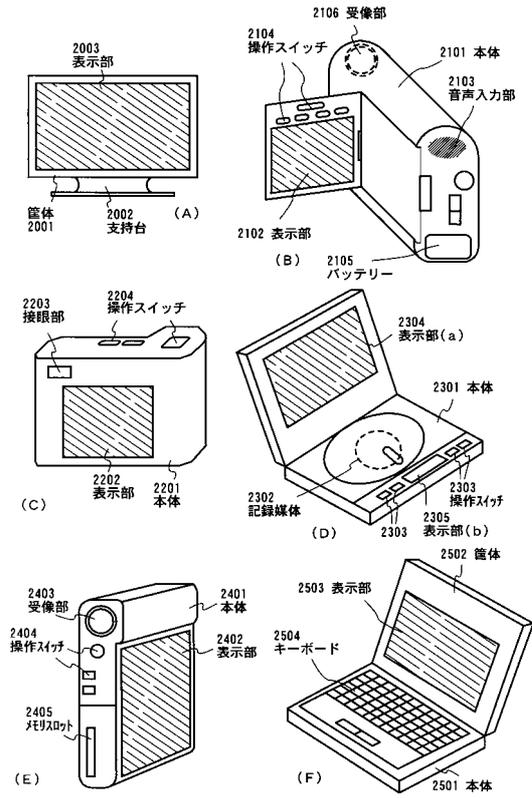
【図13】



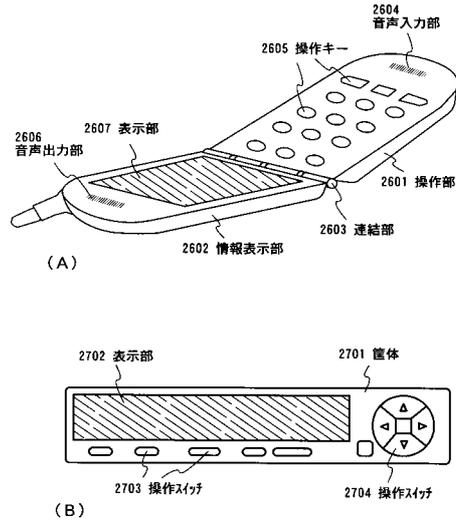
【図14】



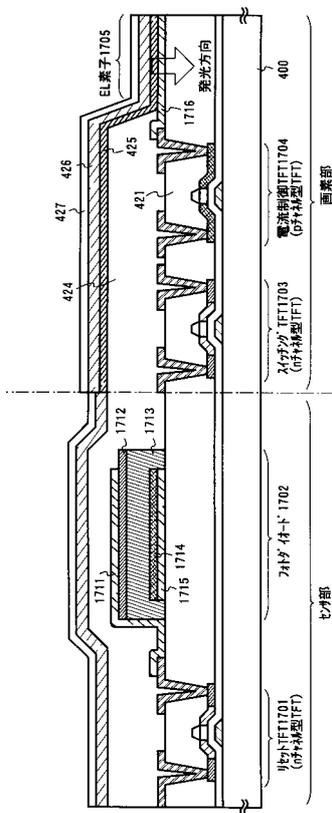
【図15】



【図16】



【図17】



フロントページの続き

(51)Int.Cl.		F I		
<i>H 0 1 L 51/50</i>	<i>(2006.01)</i>	G 0 9 F	9/30	3 6 5 Z
		G 0 9 F	9/30	3 4 9 Z
		G 0 9 F	9/00	3 6 6 G
		H 0 5 B	33/14	A
		G 0 9 G	3/20	6 8 0 G

(56)参考文献 特開2000-122574(JP,A)
 特開平10-282924(JP,A)
 特開昭61-252589(JP,A)
 特開平06-067205(JP,A)
 特開平11-075115(JP,A)

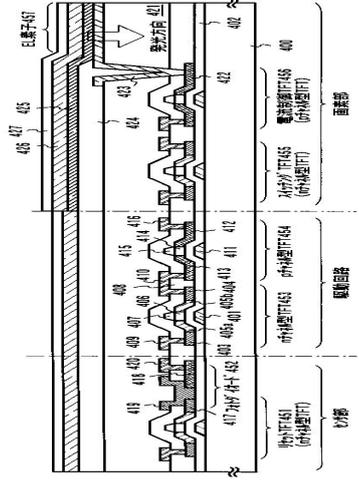
(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)

G 0 9 G	3 / 0 0	-	3 / 3 8
G 0 9 F	9 / 0 0		
G 0 9 F	9 / 3 0		
H 0 1 L	2 7 / 3 2		
H 0 1 L	5 1 / 5 0		

专利名称(译)	EL显示屏		
公开(公告)号	JP5331862B2	公开(公告)日	2013-10-30
申请号	JP2011226752	申请日	2011-10-14
[标]申请(专利权)人(译)	株式会社半导体能源研究所		
申请(专利权)人(译)	半导体能源研究所有限公司		
当前申请(专利权)人(译)	半导体能源研究所有限公司		
[标]发明人	山崎舜平 小山潤		
发明人	山崎 舜平 小山 潤		
IPC分类号	G09G3/30 G09G3/20 G09F9/30 H01L27/32 G09F9/00 H01L51/50 H05B33/08 G09G3/32 H01L21/77 H01L21/84 H01L25/16 H01L27/12 H01L51/52 H05B33/14		
CPC分类号	G01J1/44 G09G3/3275 G09G2300/0842 G09G2300/0852 G09G2310/0251 G09G2320/0233 G09G2320 /0285 G09G2320/029 G09G2320/043 G09G2320/0626 G09G2330/021 G09G2360/144 G09G2360/18 H01L25/167 H01L27/12 H01L27/1214 H01L27/124 H01L27/1288 H01L27/3269 H01L51/5281 H01L2924/0002 H01L2924/00		
FI分类号	G09G3/30.K G09G3/20.642.F G09G3/20.631.V G09G3/20.624.B G09F9/30.338 G09F9/30.365.Z G09F9/30.349.Z G09F9/00.366.G H05B33/14.A G09G3/20.680.G G09F9/30.365 G09G3/3233 G09G3 /3275 G09G3/3291 H01L27/32		
F-TERM分类号	3K107/AA01 3K107/BB01 3K107/CC14 3K107/CC32 3K107/EE04 3K107/EE68 3K107/HH04 5C080 /AA06 5C080/BB05 5C080/DD01 5C080/EE28 5C080/FF11 5C080/GG12 5C080/HH09 5C080/JJ02 5C080/JJ03 5C080/JJ06 5C080/KK01 5C080/KK07 5C080/KK23 5C080/KK43 5C080/KK47 5C080 /KK50 5C094/AA01 5C094/AA22 5C094/BA03 5C094/BA27 5C094/DA09 5C094/DA13 5C094/EA05 5C094/FB12 5C380/AA01 5C380/AB06 5C380/AB11 5C380/AB12 5C380/AB18 5C380/AB24 5C380 /AC08 5C380/AC09 5C380/AC11 5C380/AC12 5C380/AC13 5C380/BA01 5C380/BA03 5C380/BA43 5C380/CA02 5C380/CA12 5C380/CC02 5C380/CC26 5C380/CC33 5C380/CC39 5C380/CC62 5C380 /CC63 5C380/CC64 5C380/CD012 5C380/CD013 5C380/CD014 5C380/CF13 5C380/CF17 5C380 /CF41 5C380/CF46 5C380/CF48 5C380/CF49 5C380/CF66 5C380/DA02 5G435/AA01 5G435/AA16 5G435/BB05 5G435/DD11 5G435/EE49 5G435/HH12		
审查员(译)	中村直之		
优先权	2000176168 2000-06-12 JP		
其他公开文献	JP2012058739A		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

要解决的问题：提供可视性和低功耗的发光模块。一种发光模块，包括发光装置，所述发光装置包括至少一个像素部分和位于同一绝缘体上的传感器部分，所述使用环境的照度由传感器部分感测，并且所述发光元件的发光亮度并且保持发光亮度与环境照度的比率恒定。结果，即使外部环境的照度改变，也可以获得能够以适当的亮度显示的发光模块，并且可以获得可视性优异的电器。点域



400 絕緣層 401 第一層電阻層 402 第二層電阻層 403 第三層電阻層 404 第四層電阻層 405 第五層電阻層 406 第六層電阻層 407 第七層電阻層 408 第八層電阻層 409 第九層電阻層 410 第十層電阻層 411 第十一層電阻層 412 第十二層電阻層 413 第十三層電阻層 414 第十四層電阻層 415 第十五層電阻層 416 第十六層電阻層 417 第十七層電阻層 418 第十八層電阻層 419 第十九層電阻層 420 第二十層電阻層 421 第二十一層電阻層 422 第二十二層電阻層 423 第二十三層電阻層 424 第二十四層電阻層 425 第二十五層電阻層 426 第二十六層電阻層 427 第二十七層電阻層 428 第二十八層電阻層 429 第二十九層電阻層 430 第三十層電阻層 431 第三十一層電阻層 432 第三十二層電阻層 433 第三十三層電阻層 434 第三十四層電阻層 435 第三十五層電阻層 436 第三十六層電阻層 437 第三十七層電阻層 438 第三十八層電阻層 439 第三十九層電阻層 440 第四十層電阻層 441 第四十一層電阻層 442 第四十二層電阻層 443 第四十三層電阻層 444 第四十四層電阻層 445 第四十五層電阻層 446 第四十六層電阻層 447 第四十七層電阻層 448 第四十八層電阻層 449 第四十九層電阻層 450 第五十層電阻層 451 第五十一層電阻層 452 第五十二層電阻層 453 第五十三層電阻層 454 第五十四層電阻層 455 第五十五層電阻層 456 第五十六層電阻層 457 第五十七層電阻層 458 第五十八層電阻層 459 第五十九層電阻層 460 第六十層電阻層 461 第六十一層電阻層 462 第六十二層電阻層 463 第六十三層電阻層 464 第六十四層電阻層 465 第六十五層電阻層 466 第六十六層電阻層 467 第六十七層電阻層 468 第六十八層電阻層 469 第六十九層電阻層 470 第七十層電阻層 471 第七十一層電阻層 472 第七十二層電阻層 473 第七十三層電阻層 474 第七十四層電阻層 475 第七十五層電阻層 476 第七十六層電阻層 477 第七十七層電阻層 478 第七十八層電阻層 479 第七十九層電阻層 480 第八十層電阻層 481 第八十一層電阻層 482 第八十二層電阻層 483 第八十三層電阻層 484 第八十四層電阻層 485 第八十五層電阻層 486 第八十六層電阻層 487 第八十七層電阻層 488 第八十八層電阻層 489 第八十九層電阻層 490 第九十層電阻層 491 第九十一層電阻層 492 第九十二層電阻層 493 第九十三層電阻層 494 第九十四層電阻層 495 第九十五層電阻層 496 第九十六層電阻層 497 第九十七層電阻層 498 第九十八層電阻層 499 第九十九層電阻層 500 第一百層電阻層